









	<h2 style="color: red;">NTD5806NT4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD5806NT4G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 33A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NTD5806NT4G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 73983 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTD5806NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 33A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	73983 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	860pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
















































NTD5806NT4G ist neu im Original, Suche NTD5806NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD5806NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD5806NT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD5805NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 51A DPAK</p>	 <p>NTD5806NG VB NTD5806NG VB</p>	 <p>NTD5807NG O NTD5807NG O</p>	 <p>NTD5807N ON NTD5807N ON</p>
 <p>NTD5805NG O NTD5805NG O</p>	 <p>NTD5806N ON NTD5806N ON</p>	 <p>NTD5805N ON NTD5805N ON</p>	 <p>NTD5862N ON NTD5862N ON</p>

heiße Teile

Mehr

 NTD5406N	 NTD5406NG	 NTD5406NT4G	 NTD5406T4G	 NTD5407N
 NTD5407NG	 NTD5407NT4G	 NTD5412NT4G	 NTD5413N	 NTD5413NT4G
 NTD5414N	 NTD5414NT4G	 NTD5426NT4G	 NTD5802N	 NTD5802NT4G
 NTD5803N	 NTD5803NT4G	 NTD5804N	 NTD5804NG	 NTD5804NT4G
 NTD5805N	 NTD5805NG	 NTD5805NT4G	 NTD5806N	 NTD5806NG
 NTD5807N	 NTD5807NG	 NTD5807NT4G	 NTD5862N	 NTD5862NT4G
 NTD5865N-1G	 NTD5865NL	 NTD5865NL-1G	 NTD5865NLT4G	 NTD5865NT4G
 NTD5867NL	 NTD5867NL-1G	 NTD5867NLG	 NTD5867NLT4G	 NTD5867NT4G
 NTD60N02KG	 NTD60N02R	 NTD60N02R-001	 NTD60N02R-032	 NTD60N02R-035
 NTD60N02R-1G	 NTD60N02R-1R	 NTD60N02R-35G	 NTD60N02RG	 NTD60N02RG-1G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited